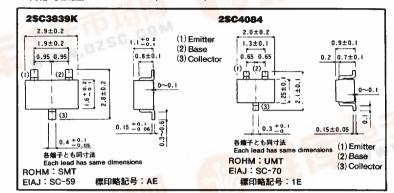
# 2**SC**3839K 2**SC**4084

# エピタキシァルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors 高周波増幅用/RF Amplifier

#### ● 特長

- 1) fr が高い。fr=2GHz (Typ.)
- 2) C<sub>C</sub>·r<sub>bb</sub>′ が小さく高利得。 C<sub>C</sub>·r<sub>bb</sub>′=3.5ps (Typ.)
- 3) NF が小さい。
- Features
- High transition frequency: f<sub>T</sub>=2GHz (Typ.)
- High gain with low collector to base time costant: C<sub>C</sub> r<sub>bb</sub> = 3.5ps (Typ.)
- 3) Low level noise figure (NF).

# ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



### ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CBO</sub>	30	٧
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	20	٧
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	3	٧
コレクタ電流	Ic	50	mA
コレクタ損失	PC	150	mW
接合部温度	Tj	150	°C
保存温度範囲	Tstg	-55~150	°C

#### ● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	ВУСВО	30		.75	٧	I <sub>C</sub> = 10 µA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BVCEO	20	YE W	-	٧	I <sub>C</sub> =1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BVEBO	3	_	_	٧	I <sub>E</sub> = 10 μA
コレクタしゃ断電流	Ісво	_	_	0.5	μA	V <sub>CB</sub> =15V
エミッタしゃ <mark>断電流</mark>	I <sub>EBO</sub>	_	_	0.5	μA	V <sub>EB</sub> = 2V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE</sub> (sat)	_	_	0.5	٧	I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub> =10mA/5mA
直流電流増幅率	hFE	27	_	270	_	V <sub>CE</sub> /I <sub>C</sub> =10V/5mA
利得帯域幅積	fT	900	2000	_	MHz	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =10mA, f=200MHz
出力容量	Cob	-	0.8	1.5	pF	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0A, f=1MHz
コレクタ・ベース時定数	C <sub>C</sub> •r <sub>bb</sub> ′	-	3.5	10	ps	V <sub>CB</sub> = 10V, I <sub>C</sub> =10mA, f=31.8MHz
維音指数	NF	Į.	3.0	025	dB	$V_{CE} = 10V, I_{C} = 2mA,$ $f = 200MHz R_{Q} = 50 \Omega$

#### hFE の値により下表のように分類します。

Item	L	М	N	Р	Q	
h <sub>FE</sub>	27~56	39~82	56~120	82~180	120~270	



ROHM

237

7828999 0011007 570 📼

2 SCタイ

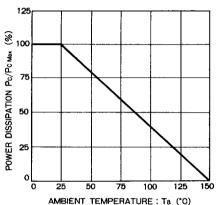
トランジスタ

● 標準品・準標準品―覧表

(○:準標準品 △:特別仕様)

	包装名	バルク	テーピング					
		記号		T146	T147	T106	T107	TP
Туре	hFE	基本発注単位(個)	200	3000	3000	3000	3000	5000
2SC3839K		LMNPQ	_	0	Δ	_	_	_
2SC4084		LMNPQ	-	_	-	0	Δ	_

## ● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves



IBIENT TEMPERATURE: Ta (\*C) Fig.1 電力軽減曲線

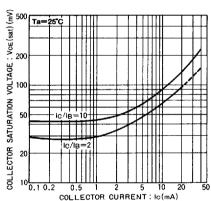


Fig.3 コレクタ・エミッタ飽和電圧 ーコレクタ電流特性

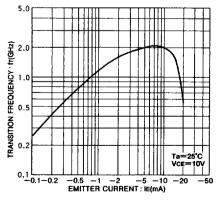


Fig.5 利得帯域幅積ーエミッタ電流特性

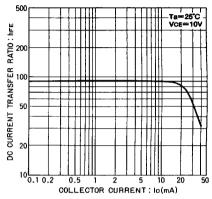


Fig.2 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

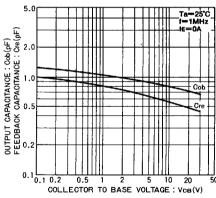
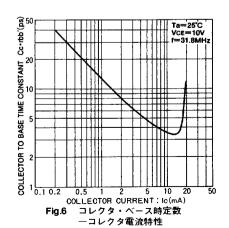


Fig.4 入出力・帰還容量—電圧特性



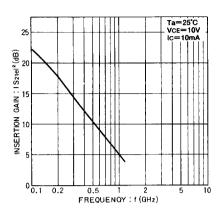


Fig.7 順方向伝達利得一周波数特性

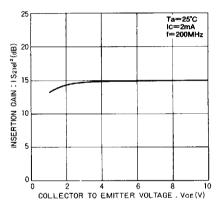


Fig.9 順方向伝達利得一コレクタ電圧特性

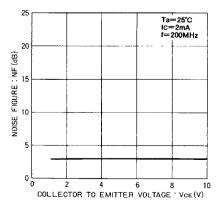


Fig.11 雑音指数-コレクタ電圧特性

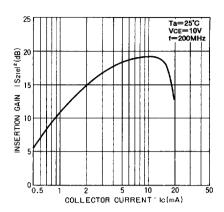


Fig.8 順方向伝達利得一コレクタ電流特性

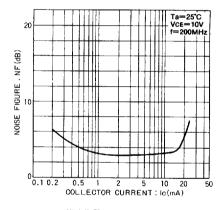


Fig.10 雑音指数--コレクタ電流特性

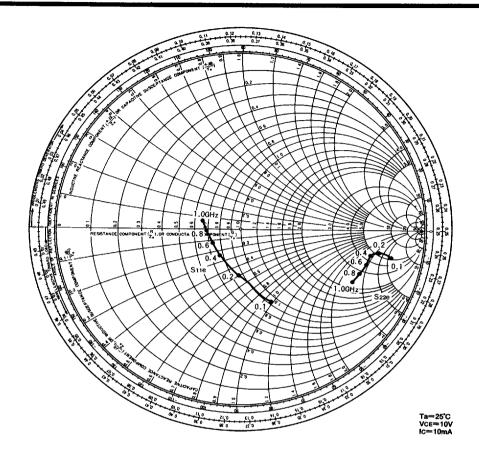
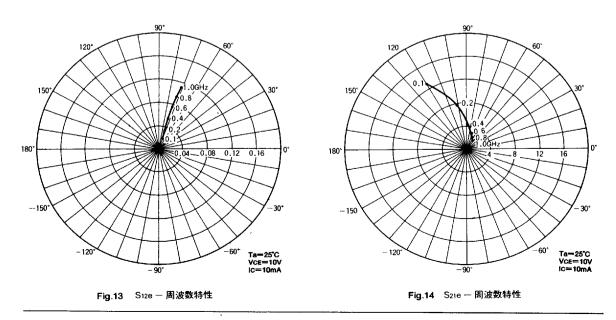


Fig.12 Siie, Siie - 周波数特性



f (MHz)	S <sub>11</sub>	∠ S <sub>11</sub>	S <sub>12</sub>	∠S <sub>12</sub>	S <sub>21</sub>	∠S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>	∠ S <sub>22</sub>
100	0.451	66	0.019	68	13.014	120	0.821	-10
200	0.251	90	0.031	70	7.639	101	0.749	-10
400	0.172	-126	0.054	73	4.039	85	0.711	-11
600	0.160	-151	0.075	72	2.829	75	0.696	-16
800	0.170	-177	0.094	71	2.175	65	0.687	-21
1000	0.198	166	0.111	70	1.771	56	0.676	26

2SC3839K TYPICAL S—PARAMETER DATA  $V_{CE}=10V,\,I_{C}=10mA,\,Z_{0}=50\,\Omega$  S—MAGNITUDE AND ANGLES (DEGREE)